

(19)日本国特許庁（J P）(12)特 許 公 報（B 2）(11)特許番号
特許第3488681号
(P3488681)
(45)発行日 平成16年 1 月19日 (2004. 1. 19)(24)登録日 平成15年10月31日 (2003. 10. 31)

(51)Int.Cl.⁷識別記号F I
G 0 2 F 1/1343G 0 2 F 1/1343
1/1333 5 0 51/1333 5 0 5
G 0 9 F 9/30 3 3 0G 0 9 F 9/30 3 3 0 Z
3 4 93 4 9 D
請求項の数 2 (全 10 頁)

(21)出願番号	特願2000－257232(P2000－257232)	(73)特許権者	000005049 シャープ株式会社 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号
(22)出願日	平成12年 8 月28日 (2000. 8. 28)	(72)発明者	小倉 雅史 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内
(65)公開番号	特開2001－194677(P2001－194677A)	(72)発明者	片岡 義晴 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内
(43)公開日	平成13年 7 月19日 (2001. 7. 19)	(72)発明者	島田 尚幸 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内
審査請求日	平成14年 7 月12日 (2002. 7. 12)	(74)代理人	100062144 弁理士 青山 葆 (外 1 名)
(31)優先権主張番号	特願平11－303823	審査官	山口 裕之
(32)優先日	平成11年10月26日 (1999. 10. 26)		
(33)優先権主張国	日本 (J P)		

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 液晶表示装置

1

(57)【特許請求の範囲】
【請求項 1】 一対の基板間に液晶層が挟持され、この液晶層が複数に分割されて成る画素領域内に光反射機能を有する反射金属膜を備えて、上記画素領域毎に上記液晶層に印加する電圧が制御される液晶表示装置において、
上記反射金属膜は、上記液晶層に電圧を印加するための電極であって、且つ、上記基板側から感光性樹脂膜および窒化モリブデン膜の順に積層されて成る積層構造体上に形成されており、
上記窒化モリブデン膜は、窒素含有量(原子%)が5%以上且つ3 0 %以下であることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項 2】 請求項 1 に記載の液晶表示装置において、上記反射金属膜が形成されている側の基板上には、

2

インジウム錫酸化膜が形成されていることを特徴とする液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【0 0 0 1】
【発明の属する技術分野】この発明は、液晶表示装置の改良に関する。
【0 0 0 2】
【従来の技術】近年、パーソナルコンピュータ等のOA (オフィス・オートメーション)機器のポータブル化が進み、OA 機器に使用される表示装置の低コスト化が重要な課題となってきた。この表示装置は、電極が形成された一対の基板で電気光学特性を有する表示媒体を挟んで形成されており、上記電極間に電圧を印加することによって上記表示媒体の電気光学特性に変化を与えて表示を行うようになっている。

10

【0003】上記表示装置としては、表示性能の点から、個々の画素にスイッチング素子を設けて、駆動可能な走査線の本数を増加させることができるアクティブマトリックス方式が主流となってきた。そして、上記走査線本数の増加等の技術によって、ディスプレイの高解像度化、光コントラスト化、多階調化および広視野角化が達成されつつある。

【0004】上記アクティブマトリックス方式の液晶表示装置においては、マトリックス状に設けられた画素電極とこの画素電極の近傍を通る走査線とが、アクティブ素子(上記スイッチング素子)を介して電気的に接続されている。上記アクティブ素子としては2端子の非線形素子(MIM)あるいは3端子の非線形素子があり、現在使用されているアクティブ素子の代表格は、3端子の非線形素子である薄膜トランジスタ(TFT)である。

【0005】また、近年、より低消費電極化の要求が高まり、通常バックライトを必要とする透過型液晶表示装置に代って、反射型液晶表示装置および反射/透過型液晶表示装置の開発が盛んである。

【0006】ここで、上記反射型液晶表示装置においては、明るい表示を得るために、反射電極の面積を拡大させ、更に、入射光を散乱させるために複数の凹凸を形成した樹脂膜上に反射電極としてA1膜を形成している。また、映像信号を送る配線と液晶駆動用のドライバとの接続には、後工程での酸化による高抵抗化を防止する等の目的で、透明電極部分等に用いられるITO(インジウム錫酸化物)が用いられている。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従来の反射型液晶表示装置においては、以下に記載するような問題がある。すなわち、上述のように複数の凹凸を形成した樹脂膜上にA1系金属膜を成膜して反射電極を形成する場合において、特に量産工程では、マスクデポ等の特殊な成膜手段を用いる他にはA1系金属膜を部分的に成膜することは不可能である。したがって、上述のように配線とドライバとを接続する端子部分や透明電極等のITO部分を含めた液晶パネル全面にA1系金属膜を成膜することになる。ところが、この反射電極膜(A1系金属膜)をパターンニングする際に、下記のような問題が生ずるのである。

【0008】上記ITO膜とA1膜とが積層された状態でA1膜を所定の形状にエッチングする場合には、フォトリソ工程を利用することになる。その場合、レジスト膜の形成に露光および現像を行うと、アルカリ系の現像液を使用することによって、ITO膜とA1膜との間で電池が構成されてしまう。その結果、A1膜とITO膜とが腐食、溶解されるので歩留まりを低下させる。この現象を電食と呼び、ITO膜とA1膜との組み合わせに限ったことではなく、アルカリ系の現像液を使用することによって電池反応が生ずる組み合わせの総てに生ずる。

【0009】この電食の問題を解決するために、A1等の金属膜を成膜する前にMo(モリブデン)を成膜して2層構造とする技術が提案されている。この技術によれば、A1およびMoの層は連続して成膜でき、また、リン酸、硝酸、酢酸および水からなる混合液によって2層同時にエッチングできるため、工程数を増やすことなく且つ電食を起こすことなく反射電極膜(A1膜)のパターンを形成できるのである。

【0010】ところで、上記樹脂膜上に反射電極として形成されたA1等の金属膜若しくは透明導電膜のパターンニングを行う場合に、レジストの剥離液による上記樹脂膜の膨潤によって上記樹脂膜と金属膜との密着力が弱まって、上記金属膜が剥がれてしまうことがしばしば見られる。上記Moの場合においても、アクリル樹脂上に成膜し、パターンニングした後にピールテストを行うと、Moが樹脂膜から剥がれてしまい、歩留りの低下につながる現象が発生するという問題がある。

【0011】ここで、上記ピールテストとは、粘着性を有する接着テープを基板上の薄膜に貼りつけ、接着テープを剥がした場合に上記薄膜が基板側に残るか接着テープに粘着するかによって、上記薄膜の基板に対する付着力の強さの程度を調べるテスト方法である。具体的には、

(1) JIS規格(JIS K-5400等)に習い、テスト膜を成膜した樹脂膜上にカッターナイフによって1mm角の100個の柵目を切る。

(2) 柵目が切られたテスト膜上に接着テープを貼り付けた後、一定の剥がし角度で剥がす。

(3) その際に、100個の柵目のうち幾つの柵目のテスト膜が剥がれたかによって、テスト膜と樹脂膜との密着性を評価する。つまり、100個の柵目が剥がれた場合には密着力が弱く、全く剥がれない場合には十分な密着力があると評価するのである。

【0012】また、一般に、高分子フィルム等の絶縁物上に金属配線を施す場合、上記高分子フィルムと金属膜との密着力が弱いことが問題となっており、従来から様々な試みがなされている。その一例として、上記金属膜の成膜に、蒸着法よりもスパッタ法を用いることが強い密着力を得る上で有効であることが紹介されている。しかしながら、上記Moを成膜する場合には、スパッタ法を用いても十分な密着力を得ることができないという問題がある。

【0013】そこで、この発明の目的は、絶縁膜上に形成された金属膜における上記絶縁膜との密着性が改善された製品歩留りおよび信頼性が高い液晶表示装置を提供することにある。

【0014】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、この発明は、一対の基板間に液晶層が挟持され、こ

の液晶層が複数に分割されて成る画素領域内に光反射機能を有する反射金属膜を備えて、上記画素領域毎に上記液晶層に印加する電圧が制御される液晶表示装置において、上記反射金属膜は、上記液晶層に電圧を印加するための電極であって、且つ、上記基板側から感光性樹脂膜およびMoN膜の順に積層されて成る積層構造体上に形成されており、上記MoN膜は窒素含有量(原子%)が5%以上且つ30%以下であることを特徴としている。

【0015】Moを窒化することによって高分子樹脂等である感光性樹脂膜とMo膜との密着性が向上される。上記構成によれば、感光性樹脂膜上にはMoN膜と反射金属膜とが順次積層されている。したがって、上記感光性樹脂膜としてアクリル樹脂を用いた場合であっても、上記アクリル樹脂と反射金属膜との密着性が向上されて、製品歩留りおよび信頼性が向上される。

【0016】さらに、上記MoN膜における窒素含有量は5%以上であるから、上記感光性樹脂膜と反射金属膜との密着性が十分向上される。また、上記窒素含有量は30%以下であるから、エッチングレートは低下することがない。したがって、上記MoN膜および反射金属膜のエッチング処理に時間を要することによるパターニング工程のスループットの悪化が防止される。

【0017】こうして、上記感光性樹脂膜と反射/画素電極との密着性が向上されて、製品歩留りおよび信頼性の高い液晶表示装置が得られる。

【0018】また、この発明の液晶表示装置は、上記反射金属膜が形成されている側の基板にはITO膜が形成されていることが望ましい。

【0019】上記構成によれば、上記反射金属膜としてAl系金属膜が用いられ、上記基板上には、例えばドライバとの接続端子や透明電極として機能するITO膜が形成されており、上記ITO膜上にAl系金属膜を形成してパターニングを行う場合でも、上記Al系金属膜とITO膜との間には上記Mo膜が形成されるため、上記Al系金属とITOとの電食反応が防止される。

【0020】

【発明の実施の形態】以下、この発明を図示の実施の形態により詳細に説明するが、この発明は以下の実施の形態に限定されるものではない。

【0021】＜第1実施の形態＞

図1は、本実施の形態の液晶表示装置としての反射型液晶表示装置の画素領域部分における平面図である。また、図2は、図1における反射基板を含む縦断面図である。

【0022】図1および図2(a)に示すように、本実施の形態における反射型液晶表示装置においては、絶縁性基板42上に、スイッチング素子としてのTF T43が形成されている。そして、このTF T43を含む絶縁性基板42上には、凹凸形状を有する層間絶縁膜としての感光性樹脂44、MoN膜45および反射電極46が順次

形成されて、滑らかな凹凸状を有する反射基板41を構成している。尚、上記MoN層45は、密着力を有して耐電食機能を備えている。また、反射電極46はAlで形成されている。

【0023】上述のごとく、ガラス等で成る絶縁性基板42上にTF T43が形成されている。このTF T43は、絶縁性基板42上に、走査信号線であるゲートバスライン47、ゲートバスライン47から分岐したTa(タンタル)で成るゲート電極48、SiNxで成るゲート絶縁層49、a-Si(アモルファスシリコン)で成る半導体層50、n型a-Siで成るn型半導体層51、データバスライン52、このデータバスライン52から分岐したITOで成るソース電極53、Ti(チタン)で成るドレイン電極54等が順次成膜されて構成される。尚、55は、エッチストップである。

【0024】また、図2(b)に示すように、上記ゲートバスラインおよびソースバスライン(共に図示せず)に信号を入力するための信号入力端子部56は、ゲートバスライン47およびゲート電極48と同時にパターニングされるTaから成る端子部電極57とITOから成る端子部接続電極部58との2層によって構成されている。

【0025】次に、上記MoN層45の構造について説明する。図3に、感光性樹脂44上にMoN膜45を成膜する際におけるN₂ガス及びAr(アルゴン)の成分比N₂/Arと、密着力との関係を示す。感光性樹脂44上におけるMoの成膜を100 sccmのArのみで行った場合は、ピールテストの結果100 柘目中100 柘目が剥がれた。ところが、Arに流量20 sccmでN₂を加えたところ、48 柘目が剥がれただけでかなり密着性が向上した。さらにN₂を増加して40 sccmで加えた場合には、剥がれる柘目は全くなかった。その場合におけるN₂の含有量(原子%)をオージェ分光分析装置によって調査した結果、N₂の含有量は約10%であった。

【0026】上記ArにN₂を流量60 sccm, 80 sccm, 100 sccmで加えた場合にも、流量40 sccmで加えた場合と同様に、剥がれる柘目は全くなかった。尚、N₂の流量を80 sccm, 100 sccmとした場合におけるN₂の含有量(原子%)は約25%, 30%であった。尚、上記オージェ分光分析装置によるN₂含有量の測定条件は以下通りである。

・オージェ分光分析装置：Perkin-Elmer社 SAM670
 ・電子ビーム加速電圧 3 kV
 ・電子ビーム電流 2 nA
 ・電子ビーム径 1600 Å
 ・電子ビーム入射角度 60°

【0027】以上の結果は、感光性樹脂44上に成膜するMoを窒化することによって、感光性樹脂(アクリル樹脂)44とMoN層45との密着力を大きくすることがで

きることを示している。その場合、Mo膜は窒化することによってエッチングレートが低下する。図3に示すように、N₂の流量が0 sccmの場合におけるMo膜のエッチングレートが最も大きく、N₂流量が増加するに連れてエッチングレートは小さくなって行き、N₂流量が100 sccmの場合には0 sccmの場合の約1/3となる。エッチングレートは小さくなるということは、それだけエッチングするために時間を要することになり、生産量が低下することを意味する。そこで、この発明においては、1/3の生産量低下を限界とし、MoN層のN₂含有量を5%以上且つ30%以下とする。

【0028】尚、上述のように、感光性樹脂44上に成膜するMo層の密着力を上げるためにMo層を窒化するのであるが、その場合、MoN膜45上に形成される反射電極46としてのA1膜とMoN膜との密着力は、A1膜とMo膜との密着力に比して低下することはない。

【0029】次に、本反射型液晶表示装置における反射基板41の製造工程、特に感光性樹脂44上に対するMoN層(凹凸形状を有して密着力を持つ電食防止膜)45およびA1で成る反射電極46の形成工程について説明する。図4および図5は、図2における反射基板41の製造工程を示すプロセス断面図である。尚、図中、左側には画素領域のプロセス断面図を示し、右側には信号入力端子部領域のプロセス断面図を示している。

【0030】まず、図4(a)に示すように、上記TFT43(図4及び図5では図示せず)が形成されたガラス等の絶縁性基板42上に、層間絶縁膜としてのポジ型の感光性樹脂44(製品名: OFPR-800: 東京応化製)を1 μm~5 μmの厚さに塗布する。本実施の形態においては3 μmの厚さで塗布した。そして、この状態で、図4(b)に示すように、図6に示すような円形の遮光部62をその面積が20%以上40%以下で形成された第1フォトマスク61を配置して、低照度の紫外線光64で均一に第1の露光を行う。次に、図4(c)に示すように、図7に示すような第2フォトマスク65配置して、コンタクトホール66の形成部を高照度の紫外線光64で第2の露光を行う。

【0031】ここで、上記第1フォトマスク61は、TFT43の位置に対応する遮光部とコンタクトホール66の位置に対応する開口部(共に図示せず)とを有している。さらに、円形遮光部62は、隣り合う円形遮光部62との中心間隔が5 μm以上且つ50 μm以下、好ましくは10 μm~20 μmになるようにランダムに配置されている。尚、63は、透明部である。また、第2フォトマスク65は、コンタクトホール66の位置に対応する透過部67を開口している。また、両フォトマスク61、65共、信号入力端子部56の位置が透過部となるような構造を有している。そして、コンタクトホール66の露光と同時に信号入力端子部56にも紫外線光64で露光可能になっている。

【0032】次に、図4(d)に示すように、現像液として東京応化工業(株)製のTMAH(テトラ・メチルアンモニウム・ハイドロオキサイド)を用いて現像を行い、上述した高照度露光部分(上記2度の露光が行われたコンタクトホール66および信号入力端子部56の部分)の感光性樹脂44を完全に除去する。また、低照度露光部分(上記第1の露光による1度の露光が行われた透明部63の部分)68の感光性樹脂44を初期の膜厚に対して約40%残膜させ、未露光部分(TFT43および上記円形遮光部62の部分)の感光性樹脂44を初期の膜厚に対して約80%残膜させる。

【0033】次に、200℃で60分間の加熱処理を行い、図4(e)に示すように、熱だれ現象によって感光性樹脂44を変形させて、表面に滑らかな凹凸を形成する。そして、図5(f)に示すように、絶縁性基板42上にMoNとA1とをスパッタリング法によって各々500 Å, 1000 Åの膜厚で形成する。そして、図5(g)~図5(k)に示すように、1つのTFT43に1つの反射電極46が存在するようにパターニングを行い、MoN膜45とA1膜46との積層膜を形成するのである。

【0034】尚、上記MoN膜は、DCマグネトロンスパッタ法によって、100 sccmのAr, 40 sccmのN₂によって、ガス圧が0.5 Paの雰囲気下で成膜する。また、上記A1膜は、100 sccmのAr, ガス圧が0.4 Paの雰囲気下で成膜する。また、上記MoN膜45と反射電極46の積層膜のパターニングは、図5(g)に示すようにフォトレジスト69を塗布し、図5(h)に示すように画素電極毎に分離するためのヌキ部および信号入力端子部56を紫外線光64で露光し、図5(i)~図5(k)に示すように、現像工程、エッチング工程および剥離工程を行うことによって行うのである。

【0035】以上のような工程によって、滑らかで高密度な凹凸部を有する反射電極46を形成できる。このような反射基板46は、平坦部が減少しているため、正反射成分の少ない理想的な反射特性を実現することが可能である。また、感光性樹脂44のフォトリソ回数削減することが可能であり、反射電極46の製造に必要なコストの低減も可能である。

【0036】最後に、上述のように形成された反射基板41と透明電極を支持するカラーフィルタ基板(共に図示せず)とをスペーサーを介して貼り合わせ、上記両基板間に液晶を注入して、上記カラーフィルタ基板に位相差板と偏光板とを貼り付けて反射型液晶表示装置が完成する。

【0037】上述のように、本実施の形態においては、反射型液晶表示装置を作成するに際して、絶縁性基板42上にTFT43を形成し、さらにTFT43を覆って層間絶縁膜としての感光性樹脂44を成膜する。そして、円形遮光部62が散在された第1フォトマスク61と第2フォトマスク65とで2回の露光を行い、感光性樹脂

44にコンタクトホール66を形成すると共に、TFT43以外の領域に滑らかな凹凸を形成する。その後、上記凹凸が形成された感光性樹脂44上にMoN膜45および反射電極46とを順次積層して、滑らかで高密度な凹凸を有する反射電極46を形成するようにしている。

【0038】したがって、正反射成分が少なくペーパーホワイト表示が可能な反射電極46を1つの画素領域内に有する反射型基板41を形成することができる。

【0039】その際に、上記絶縁性基板42上全面に反射電極46を成膜する際にはMoN膜45上に成膜している。そのために、図5(f)に示すように、A1膜である反射電極46と信号入力端子部56を構成するITOから成る端子部接続電極部58との間にはMoN膜45が存在することになる。したがって、MoN層45と反射電極46との積層膜をパターンニングするに際して、フォトリソによるレジスト膜の形成時にアルカリ系の現像液を使用しても、MoN層45の存在によってITO膜とA1膜との間で電食現象は発生しないのである。

【0040】また、上記感光性樹脂44上にMoN膜45を成膜する場合、N₂の含有量が5原子%より小さい場合には感光性樹脂(アクリル樹脂)44に対するMoN層45の密着力は低く、実用的ではない。また、30原子%より大きい場合にはエッチングレートが低下してしまい、エッチング処理に時間を要してしまう。その場合には、MoN層45と反射電極46とのパターンニング工程のスループットが悪化してしまう。すなわち、本実施の形態においては、MoN膜45におけるN₂の含有量を5原子%以上且つ30原子%以下にすることによって、感光性樹脂44に対するMoN層45の高い密着力を得ることができ、且つ、エッチングレートの低下を抑制してパターンニング工程のスループットの悪化を防止できるのである。

【0041】＜第2実施の形態＞

図8は、本実施の形態の液晶表示装置としての透過/反射両用型液晶表示装置の画素領域部分における平面図である。また、図9は、図8におけるA-A'矢視断面図である。

【0042】本実施の形態における透過/反射両用型液晶表示装置においては、図9に示すように、絶縁性基板2上に、スイッチング素子としてのTFT3が形成されている。そして、このTFT3を含む絶縁性基板2上には、凹凸形状を有する層間絶縁膜としての感光性樹脂4、MoN膜5及び反射電極6が順次形成されて、透過/反射両用基板1を構成している。さらに、絶縁性基板2上には透明電極7が形成されている。尚、上記MoN層5は、密着力を有して耐電食機能を備えている。また、反射電極6はA1で形成され、透明電極7はITOで形成されている。そして、反射電極6および透明電極7によって、画素領域の反射部および透過部を構成しているのである。

【0043】また、上記透過/反射両用基板1に対向するカラーフィルタ基板8上には、カラーフィルタ層9と透明電極10とが順次形成されている。そして、透明電極10側を反射電極6側に向けて互いに対向した透過/反射両用基板1とカラーフィルタ基板8との間には、液晶層11が設けられている。また、両基板1,8の外側には、位相差板12,12と偏光板13,13とが配置されている。さらに、透過/反射両用基板1側の最も外側には、バックライト14が配置されている。

【0044】尚、本実施の形態においては、液晶表示モードとして偏光モードを使用しているが、この発明はこれに限定されるものではない。例えば、ゲストホストモードを使用すれば、位相差板12および偏光板13は省略することが可能になる。

【0045】上述のごとく、図8および図9に示すように、ガラス等で成る絶縁性基板2上にTFT3が形成されている。このTFT3は、絶縁性基板2上に、走査信号線であるゲートバスライン15、このゲートバスライン15から分岐したTaで成るゲート電極17、SiNxで成るゲート絶縁層18、a-Siで成る半導体層19、n型a-Siで成るn型半導体層20、データバスライン16、このデータバスライン16から分岐したTaとITOとの積層膜で成るソース電極21、TaとITOとの積層膜で成るドレイン電極22等が順次成膜されて構成される。このTFT3は、ドレイン電極22をデータバスライン16に接続するスイッチング素子として機能する。尚、23は、半導体層19に形成されるチャネル領域である。

【0046】上記ドレイン電極22の延長部はITOのみで形成されており、このITO部分が画素電極の一部を構成する透明電極7となっている。また、上述のように上記画素電極の一部を構成する反射電極6は、MoN層5およびコンタクトホール24を介してドレイン電極22に接続されており、層間絶縁膜としての感光性樹脂4を介して透明電極7上に延在している。尚、MoN層5のN₂含有量は、上記第1実施の形態と同様に5%以上且つ30%以下である。

【0047】次に、本透過/反射両用型液晶表示装置における透過/反射両用基板1の製造工程、特に感光性樹脂4に対するMoN層(凹凸形状を有して密着力を持つ電食防止膜)5およびA1で成る反射電極6の形成工程について説明する。図10は、図9における透過/反射両用基板1の製造工程を示すプロセス断面図である。尚、本実施の形態においても、上記第1実施の形態の場合と同様に、端子部電極とITOから成る端子部接続電極部との2層構成を有する信号入力端子部を備えている。しかしながら、この信号入力端子部に対する製造プロセスは上記第1実施の形態の場合と同じであるため図10においては省略し、画素領域のみを記載している。

【0048】先ず、図10(a)に示すように、上記TFT

T3および透明電極7が形成された絶縁性基板2の表面に、層間絶縁膜としての感光性樹脂4を $1\mu\text{m}\sim 5\mu\text{m}$ の厚さに塗布する。本実施の形態においては $4\mu\text{m}$ で成膜した。そして、この状態で、図11に示すような第1フォトマスク25を配置して、 52mJ で第1の露光を行う。次に、図10(b)に示すように、図12に示すような第2フォトマスク26を配置して第2の露光を行う。

【0049】ここで、上記第1フォトマスク25は、図11に示すように、TF T3に対応する領域27は完全に遮光し、コンタクトホール24に対応する領域28および上記透過領域に対応する領域29は完全に開口し、その他の領域には円形遮光部30を散在させて構成されている。また、第2フォトマスク26は、図12に示すように、コンタクトホール24に対応する領域31および上記透過領域に対応する領域32のみを完全に開口して構成されている。

【0050】そうした後に、絶縁性基板2上の感光性樹脂4を現像する。そうすると、上記第1の露光のみによって光が照射された領域の感光性樹脂4は、1回だけの露光であるため露光強度が弱い。したがって、完全に除

去されることはなく、且つ、両フォトマスク25,26で覆われて全く露光されていない領域(TF T3上の領域)よりも10~50%膜減りする。その結果、図10(c)に示すように、表面に凹凸形状が形成された状態となる。

【0051】これに対して、上記第1,第2の露光によって光が照射された領域(コンタクトホール24形成部と透過部との領域)の感光性樹脂4は、2回の露光であるため露光強度が強く、図10(c)に示すように、完全に除去されることになる。

【0052】次に、図10(d)に示すように、上述のごとく滑らかな凹凸が形成された感光性樹脂4上に、MoNとA1とをスパッタリングによって $500\text{\AA}$ 、 $1000\text{\AA}$ 程度の膜厚に順次形成する。そして、1つのTF T3上に1つの反射電極6が存在するようにパターニングを行い、MoN層5とA1の反射電極6との積層膜を形成するのである。

【0053】尚、上記MoN膜は、DCマグネトロンスパッタ法によって、 100 sccm のAr、 40 sccm の N_2 によって、ガス圧が 0.5 Pa の雰囲気下で成膜する。また、上記A1膜は、 100 sccm のAr、ガス圧が 0.4 Pa の雰囲気下で成膜する。また、上記パターニングは、フォトリソによるマスクパターン形成後、リン酸、硝酸、酢酸および水からなる混合液によって上記MoN膜とA1膜との2層を同時にエッチングすることによって行う。

【0054】また、上記反射電極6は、コンタクトホール24を介してTF T3のドレイン電極22に接続されると共に、感光性樹脂4上に形成された滑らかな凹凸に沿って形成されている。したがって、表示に寄与する反射電極6の表面にも、感光性樹脂4の凹凸に応じた不規

則な円形の凹凸が存在するのである。

【0055】上述のように、本実施の形態においては、透過/反射両用型液晶表示装置を作成するに際して、絶縁性基板2上にTF T3及び透明電極7を形成し、さらにTF T3を覆う反射部には層間絶縁膜としての感光性樹脂4を成膜する。そして、円形遮光部30が散在された第1フォトマスク25と第2フォトマスク26とで2回の露光を行い、感光性樹脂4にコンタクトホール24および上記透過領域を形成すると共に、TF T3以外の領域に滑らかな凹凸を形成する。その後、上記凹凸が形成された感光性樹脂4上にMoN膜5および反射電極6とを順次積層して、滑らかで高密度な凹凸を有する反射電極6を形成するようにしている。

【0056】したがって、正反射成分が少なくペーパーホワイト表示が可能な反射電極6と透明電極7とを1つの画素領域内に有する透過/反射両用型基板1を形成することができる。

【0057】その際に、上記A1膜である反射電極6は、ITO膜である透明電極7やITOとTaとの2層膜であるソース電極21およびドレイン電極22と、層間絶縁膜としての感光性樹脂4およびMoN膜5を介して対向している。したがって、MoN層5と反射電極6との積層膜をパターニングするに際して、フォトリソによるレジスト膜の形成時にアルカリ系の現像液を使用しても、MoN層5の存在によってITO膜とA1膜との間で電食現象は発生しないのである。

【0058】また、上記説明では省略しているが、上記感光性樹脂4上にA1膜である反射電極6を成膜する際にはMoN膜5上に成膜している。そのために、上述のごとくITOから成る端子部接続電極部上に反射電極6が成膜された場合には、端子部接続電極部(ITO)とA1膜(反射電極6)との間にはMoN膜5が存在することになる。したがって、MoN層5と反射電極6との積層膜をパターニングするに際してアルカリ系の現像液を使用しても、MoN層5の存在によってITO膜(端子部接続電極部)とA1膜(反射電極6)との間で電食現象は発生しないのである。

【0059】また、本実施の形態においても、上記MoN膜5における N_2 の含有量を5原子%以上で且つ30原子%以下にすることによって、感光性樹脂4に対するMoN層5の高い密着力を得ることができ、且つ、エッチングレートの低下を抑制してパターニング工程のスループットの悪化を防止できるのである。

【0060】＜第3実施の形態＞

上述したように、 N_2 含有量が5原子%以上且つ30%以下であるMoN層は、高分子樹脂に対して高い密着力を得ることができ、且つ、エッチングレートの低下を抑制してパターニング工程のスループットの悪化を防止できる。本実施の形態は、上記MoNの利点を利用して、樹脂上にMoNの配線パターンを形成して成る配線基板

に関する。

【0061】図13は、本実施の形態の配線基板の部分断面図である。71はPETフィルムであり、72はMoN配線であり、73はMo配線である。上記構成の配線基板は、次のようにして形成される。

【0062】先ず、上記PETフィルム71上に、Arガス流量100sccm、N₂ガス流量40sccm、真空度0.50Paの雰囲気中で、MoN膜を成膜する。さらに、Arガス流量100sccm、真空度0.50Paの雰囲気中で、Mo膜を約1000Åの膜厚で成膜する。その後、フォトリソおよびエッチングを行って上記MoN膜およびMo膜を所定の配線形状にパターンニングする。こうして、MoN配線72およびMo配線73が形成されるのである。

【0063】ここで、上記MoN配線72とMo配線73との二層構造に成膜するのは、MoN配線72のみでは抵抗値が高く、単独では配線として使用することが不可能であるためである。尚、本実施の形態におけるMoN膜形成時のN₂ガス流量は、40sccmに限定するものではなく、上記第1、第2実施の形態の場合と同様に、20sccm以上で且つ100sccmの範囲であればよい。そうすることによって、MoN膜におけるN₂含有量を5原子%以上で且つ30原子%以下にすることができる。その結果、PETフィルム71に対するMoN配線72の高い密着力を得ることができ、且つ、エッチングレートの低下を抑制してパターンニング工程のスループットの悪化を防止できるのである。また、得られた配線基板の用途は特に限定するものではないが、上記第1、第2実施の形態の液晶表示装置に適用しても差し支えない。

【0064】

【発明の効果】以上より明らかなように、この発明の液晶表示装置は、画素領域内に設けられた反射金属膜は、基板側から感光性樹脂膜およびMoN膜の順に積層されて成る積層構造体上に形成されているので、上記感光性樹脂膜と反射金属膜との間には、上記感光性樹脂膜との密着性が高いMoN膜を介在させることができる。したがって、上記感光性樹脂膜としてアクリル樹脂を用いた場合であっても、上記アクリル樹脂と反射金属膜との密着性を向上できる。

【0065】すなわち、この発明によれば、上記反射金属膜がアクリル樹脂から剥がれることを防止して、製品歩留りおよび信頼性の高い液晶表示装置を提供することができるのである。

【0066】さらに、上記MoN膜の窒素含有量(原子%)を5%以上且つ30%以下にしているので、上記MoN膜における窒素含有量を5%以上にして上記感光性樹脂膜と反射金属膜との密着性を十分向上できる。また、上記窒素含有量を30%以下にしてエッチングレートの低下を抑制できる。したがって、上記MoN膜および反射金属膜のエッチング処理に時間を要することによるパターンニング工程のスループットの悪化を防止できる。

【0067】また、この発明の液晶表示装置は、上記反射金属膜が形成されている側の基板上にITO膜(ドライバとの接続端子や透明電極)を形成すれば、上記反射金属膜としてAl系金属膜を上記ITO膜上に形成してパターンニングを行う場合でも、上記Al系金属膜とITO膜との間には上記Mo膜が形成されているため、上記Al系金属とITOとの電食反応を防止できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 この発明の液晶表示装置としての反射型液晶表示装置の画素領域部分における平面図である。

【図2】 図1における反射基板を含む縦断面図である。

【図3】 MoN膜の成膜時におけるN₂の流量と密着力との関係を示す図である。

【図4】 反射基板の製造工程を示すプロセス断面図である。

【図5】 図4に続く示すプロセス断面図である。

【図6】 図4における第1フォトマスクの平面図である。

【図7】 図4における第2フォトマスクの平面図である。

【図8】 この発明の液晶表示装置としての透過/反射両用型液晶表示装置の画素領域部分における平面図である。

【図9】 図8におけるA-A'矢視断面図である。

【図10】 図9における透過/反射両用基板の製造工程を示すプロセス断面図である。

【図11】 図10における第1フォトマスクの平面図である。

【図12】 図10における第2フォトマスクの平面図である。

【図13】 この発明の配線基板における部分断面図である。

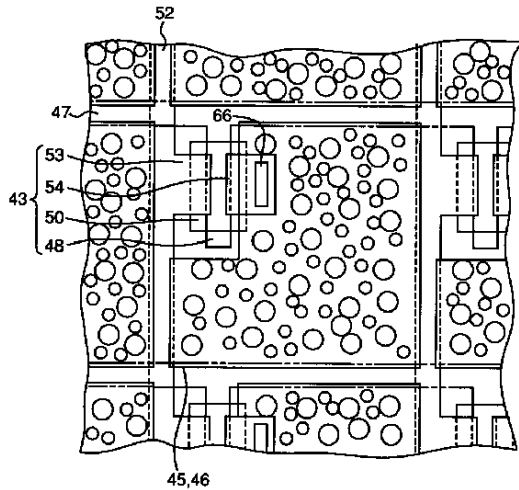
【符号の説明】

- 1…透過/反射両用基板、
- 2,42…絶縁性基板、
- 3,43…TFT、
- 4,44…感光性樹脂、
- 5,45…MoN膜、
- 6,46…反射電極、
- 7,10…透明電極、
- 8…カラーフィルタ基板、
- 11…液晶層、
- 17,48…ゲート電極、
- 19,50…半導体層、
- 20,51…n型半導体層、
- 21,53…ソース電極、
- 22,54…ドレイン電極、
- 24,66…コンタクトホール、
- 25,61…第1フォトマスク、

15

26, 65…第2フォトマスク、
 30, 62…円形遮光部、
 41…反射基板、
 56…信号入力端子部、
 57…端子部電極、

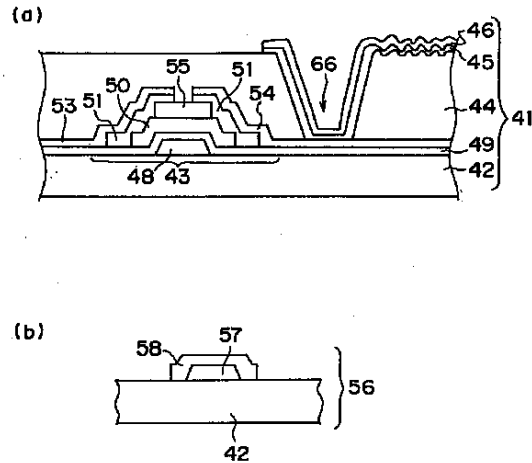
【図1】



16

* 58…端子部接続電極部、
 69…フォトリソ、
 71…PETフィルム、
 72…MoN配線、
 * 73…Mo配線。

【図2】

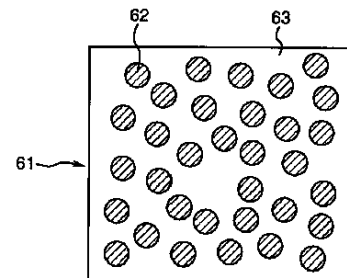


【図3】

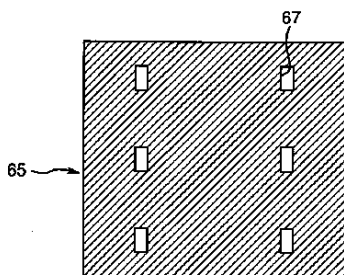
	Ar流量	N ₂ 流量	エッチングレート(nm/min.)	ピールテストの結果	密着力	オージェによるN ₂ の原子%
条件1	100	0	754	100/100	×	
条件2	100	20	648	48/100	△	5
条件3	100	40	562	0/100	○	10
条件4	100	60	476	0/100	○	
条件5	100	80	319	0/100	○	25
条件6	100	100	257	0/100	○	30

× ほとんどの画素がはがれる
 △ 一部の画素がはがれる
 ○ 全くはがれる

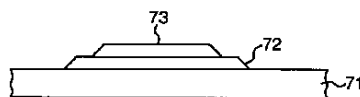
【図6】



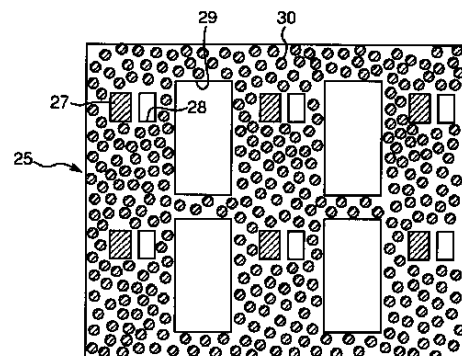
【図7】



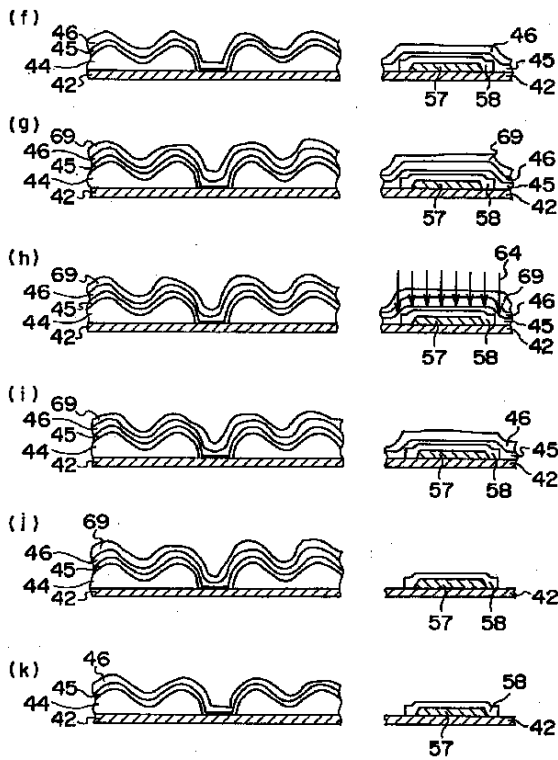
【図13】



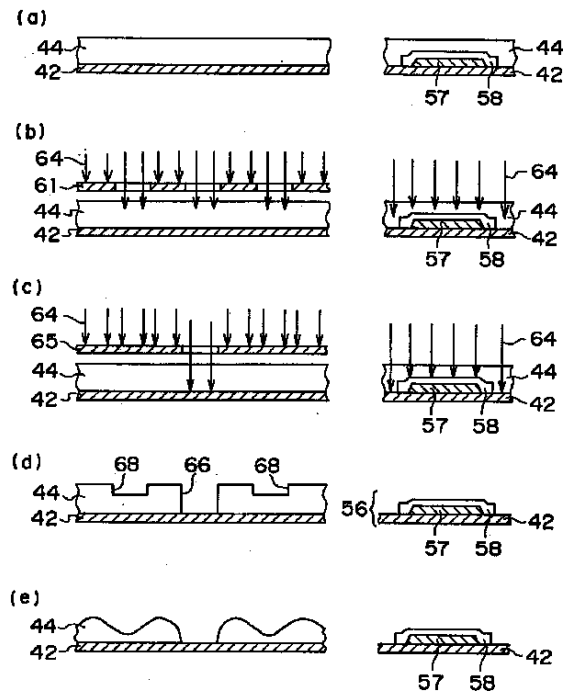
【図11】



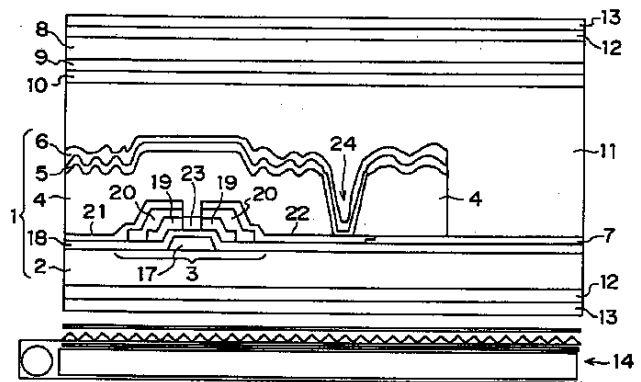
【図4】



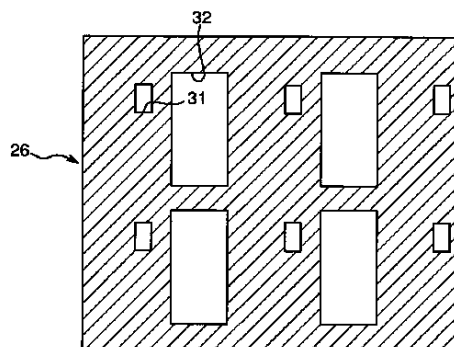
【図5】



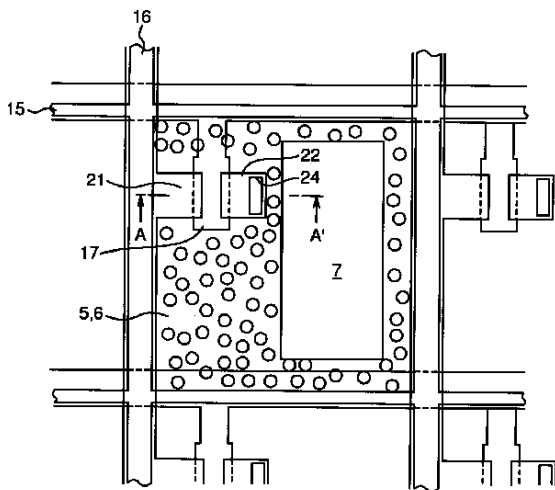
【図9】



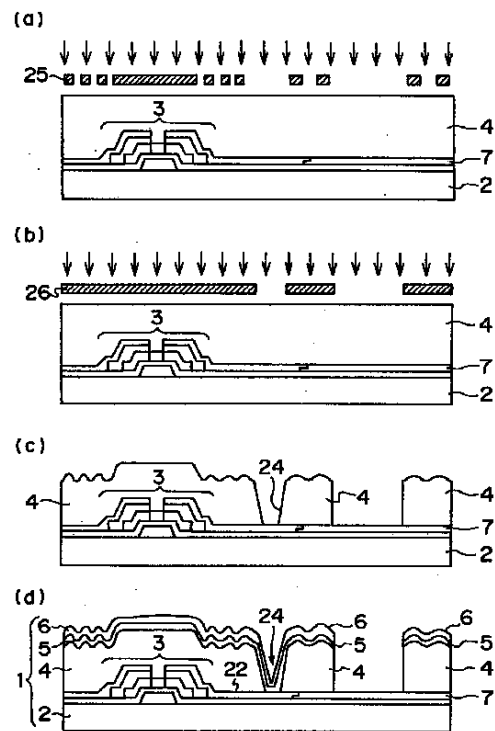
【図12】



【図8】



【図10】



フロントページの続き

(56)参考文献 特開 平10-133597 (J P, A)
 特開 平10-20319 (J P, A)
 特開 平11-38440 (J P, A)
 特開 平11-281972 (J P, A)

(58)調査した分野(Int.Cl.⁷, D B名)
 G02F 1/1343
 G02F 1/1333

专利名称(译)	液晶表示装置		
公开(公告)号	JP3488681B2	公开(公告)日	2004-01-19
申请号	JP2000257232	申请日	2000-08-28
[标]申请(专利权)人(译)	夏普株式会社		
申请(专利权)人(译)	夏普公司		
当前申请(专利权)人(译)	夏普公司		
[标]发明人	小倉雅史 片岡義晴 島田尚幸		
发明人	小倉 雅史 片岡 義晴 島田 尚幸		
IPC分类号	G02F1/1333 G09F H01L27/12 C09K19/00 G02F1/1343 H01L21/77 G02F1/136 H01L21/70 G02F1/00 G02F G02F1/1335 G09F9/30 G09F9/35 G02F1/1362		
CPC分类号	G02F2203/02 G02F2001/13629 G02F2001/136295 H01L27/12 G02F1/13439 G02F1/136286 H01L27/1214 G02F2201/07 G02F2202/28 H01L27/124 Y10T428/10 Y10T428/1059 Y10T428/1064 Y10T428/1086 Y10T428/1095 Y10T428/31678		
FI分类号	G02F1/1343 G02F1/1333.505 G09F9/30.330.Z.349.D G02F1/1333.500 G02F1/1335.520 G09F9/30.330 G09F9/30.330.Z G09F9/30.349.D		
F-TERM分类号	2H090/HD05 2H090/HD08 2H090/LA01 2H090/LA20 2H091/FA02 2H091/FA02Y 2H091/FA08 2H091/FA08X 2H091/FA08Z 2H091/FA11 2H091/FA11X 2H091/FA11Z 2H091/FA14 2H091/FA14Y 2H091/FA31 2H091/FA31Y 2H091/FA41 2H091/FA41Z 2H091/FB02 2H091/FB08 2H091/FC10 2H091/FC26 2H091/GA02 2H091/GA03 2H091/GA07 2H091/GA13 2H091/HA08 2H091/KA10 2H091/LA02 2H091/LA12 2H092/HA05 2H092/HA06 2H092/JA24 2H092/JB07 2H092/KA05 2H092/KA12 2H092/KA18 2H092/KB25 2H092/MA05 2H092/MA13 2H092/MA18 2H092/NA17 2H092/NA18 2H092/NA27 2H092/NA28 2H092/NA29 2H092/PA08 2H092/PA10 2H092/PA12 2H092/PA13 2H190/HD05 2H190/HD08 2H190/LA01 2H190/LA20 2H191/FA02Y 2H191/FA22X 2H191/FA22Z 2H191/FA30X 2H191/FA30Z 2H191/FA34Y 2H191/FA45Y 2H191/FB14 2H191/FC02 2H191/FC10 2H191/FC32 2H191/FC36 2H191/FD22 2H191/LA13 2H191/NA13 2H191/NA32 2H191/NA34 2H191/NA37 2H191/PA65 2H291/FA02Y 2H291/FA22X 2H291/FA22Z 2H291/FA30X 2H291/FA30Z 2H291/FA34Y 2H291/FA45Y 2H291/FB14 2H291/FC02 2H291/FC10 2H291/FC32 2H291/FC36 2H291/FD22 2H291/LA13 2H291/NA13 2H291/NA32 2H291/NA34 2H291/NA37 2H291/PA65 5C094/AA42 5C094/AA43 5C094/BA03 5C094/BA43 5C094/CA19 5C094/DA13 5C094/DB04 5C094/EA04 5C094/EA05 5C094/EA06 5C094/EB02 5C094/ED11 5C094/ED13 5C094/FA02 5C094/FB02 5C094/FB12 5C094/FB15 5C094/GB10 5C094/JA01		
审查员(译)	山口博之		
优先权	1999303823 1999-10-26 JP		
其他公开文献	JP2001194677A		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：改善与绝缘膜上形成的金属膜中的绝缘膜的粘附性。解决方案：在绝缘基板42上形成TFT43，并形成覆盖TFT3的光敏树脂44的膜。通过第一和第二光掩模进行两次曝光，其中圆形光屏蔽部分废物分布，在光敏树脂44中形成接触孔66，并且在

除TFT TFT之外的区域中形成平滑的粗糙度。此外， MoN膜45和反射器电极46依次层叠在光敏树脂44上。在这种情况下，通过设定MoN膜45中的N 2含量，可以获得MoN层45对光敏树脂4的高粘合强度。可以抑制5原子%至30原子%，并且可以抑制蚀刻速率的降低。

	Ar流量	N ₂ 流量	エッチングレート(nm/min.)	ピールテストの結果	密着力	オージェによるN ₂ の原子%
条件1	100	0	754	100/100	×	
条件2	100	20	648	48/100	△	5
条件3	100	40	562	0/100	○	10
条件4	100	60	476	0/100	○	
条件5	100	80	319	0/100	○	25
条件6	100	100	257	0/100	○	30